

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2003-059520
起案日	平成21年 4月 6日
特許審査官	小川 将之 9634 4M00
特許出願人代理人	新居 広守 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

<<<< 最 後 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・請求項1-7, 9-10, 15-22

理由1, 2

引用例1-2

<備 考>

引用例1の段落【0046】-【0115】、又は、引用例2の段落【0033】-【0061】を、それぞれ参照。

・請求項1-6, 11-16, 18-22

理由2

引用例3

<備考>

引用例3の段落【0051】—【0071】及び図4を参照。引用例3のp型ZnO系半導体におけるS、Se、Teの含有量は、必要なバンドギャップや格子整合性等を考慮して当業者が適宜設定し得た事項であり、その具体的数値として単に2atm%以下の数値を設定することは当業者が適宜なし得たことである。また、その効果についても、本願明細書段落【0016】において「また、前記局在バンド形成元素の含有量は、2atom%以下であつてもよい。」、又は、本願明細書段落【0036】において「そして、局在バンド形成元素120の濃度が高い場合、禁制帯220の幅が狭くなり、母体材料100の特性が薄れてしまう。よって、局在バンド形成元素120の含有量は、2atom%以下に設定するのが好ましい。」と記載されているに過ぎず、「2atom%以下」の場合が「2atom%を越える」場合と比較して格別の効果を有することが具体的に示されているわけではないから、「2atom%以下」に設定することに臨界的意義は認められない。

最後の拒絶理由通知とする理由

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項8に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特開2002-270969号公報
2. 特開平5-243614号公報
3. 特開2002-118328号公報